

КП749А-Г

МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР

АДБК 432140.684 ТУ

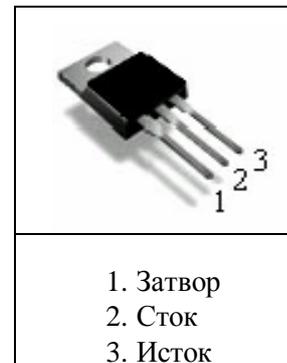
КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ И ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ, В РЕГУЛЯТОРАХ, СТАБИЛИЗАТОРАХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, БЛОКАХ ПИТАНИЯ ЭВМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ.

* Зарубежный аналог - **IRF620, 621, 622, IRL620**

* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения			
			А	Б	В	Г
Напряжение сток-исток	Uси max	В	200	150	200	200
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20	±20
Постоянный ток стока при Tк=25 С	Iс max	А	5.2	5.2	4.0	5.2
Постоянный ток стока при Tк=100 С	Iс max	А	3.3	3.3	2.7	3.3
Импульсный ток стока	Iс и max	А	18	18	16	18
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	50	50	50	50
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150	150



В диапазоне температур корпуса от 25 до 100 °С максимально-допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле $P_{max} = (T_{пер\ max} - T_{корп}) / R_{t\ п-к}$

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (T_{корп.}=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Iс=0.25мА, Uзи=Uси	2.0	4.0
Ток стока	Iс	А	tи<300мкс. Q >50 Uси=5.4В, Uзи=10В Uси=5.4В, Uзи=10В	5.2 4.0	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Rси отк	Ом	tи<300мкс. Q >50 Iс=3.1А, Uзи=10В Iс=2.5А, Uзи=10В Iс=2.5А, Uзи=10В		0.8 0.8 1.2
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Uси= Uси max, Uзи=0		250
Ток утечки затвора	Iз ут.	нА	tи<300мкс. Q >50 Uси=0, Uзи= Uзи max	-100	+100
Крутизна ВАХ	S	А/В	tи<300мкс. Q >50 Uси=25В, Iс=3.1А Uси=25В, Iс=2.5А	1.5 1.3	
Время включения/выключения	* твкл/ твыкл	нс	tи ≤300мкс. Q ≥50, Uси=100В, Iс=4.8А, Rг=18 Ом, Rс=20 Ом Uси=100В, Iс=4.8А, Rг=18 Ом, Rс=20 Ом		29.2/32 37.4/59
Тепловое сопротивление переход-корпус	* Rt п-к	°С/Вт			2.5
Тепловое сопротивление переход-среда	* Rt п-с	°С/Вт			62
Емкость: входная/выходная проходная	*C11и/C22и C12и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		340/130 40 800/240 76
Прямое напряжение диода	Uпр	В	Uзи=0, Iс= -5.2А Uзи=0, Iс=-4А		1.8 1.6

* Справочные параметры

Диапазон рабочих температур корпуса от -55 до +150°С

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>